**Ермошин Иван Геннадьевич. Разработка основ технологии получения эпитаксиальных слоев GaN,InxGa1-xN и AlxGa1-xN методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений для светоизлучающих структур : диссертация ... кандидата технических наук : 05.27.06 / Ермошин Иван Геннадьевич; [Место защиты: Нац. исслед. технологич. ун-т МИСиС].- Москва, 2009.- 135 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-5/3557**